

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第3区分  
 【発行日】令和1年11月28日(2019.11.28)

【公開番号】特開2017-85565(P2017-85565A)  
 【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)  
 【年通号数】公開・登録公報2017-018  
 【出願番号】特願2016-208295(P2016-208295)  
 【国際特許分類】

H 0 3 K 3/356 (2006.01)  
 H 0 1 L 29/786 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/8234 (2006.01)  
 H 0 1 L 27/088 (2006.01)  
 H 0 3 K 19/173 (2006.01)  
 H 0 3 K 19/177 (2006.01)

【F I】

H 0 3 K 3/356 B  
 H 0 1 L 29/78 6 1 8 B  
 H 0 1 L 29/78 6 1 4  
 H 0 1 L 27/08 1 0 2 E  
 H 0 3 K 19/173 1 0 1  
 H 0 3 K 19/177

【手続補正書】

【提出日】令和1年10月18日(2019.10.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1および第2の回路と、第1乃至第3の配線と、第1乃至第4のトランジスタと、を有し、

前記第1の回路は、前記第1の配線と電氣的に接続され、

前記第1の回路は、前記第1のトランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第1のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第2の配線と電氣的に接続され、

前記第1のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第2のトランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第2の回路は、前記第1の配線と電氣的に接続され、

前記第2の回路は、前記第3のトランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第3の配線と電氣的に接続され、

前記第3のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第4のトランジスタのゲートと電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第2のトランジスタのソースまたはドレインの一方と電氣的に接続され、

前記第4のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第2のトランジスタのソースまたはドレインの他方と電氣的に接続される、半導体装置。

**【請求項 2】**

請求項 1 において、

前記第 1 の配線は、第 1 のコンフィギュレーションデータを前記第 1 の回路に供給し、  
第 2 のコンフィギュレーションデータを前記第 2 の回路に供給する機能を有し、

前記第 2 の配線は、第 1 のコンテキストデータ信号を前記第 2 のトランジスタのゲート  
に供給する機能を有し、

前記第 3 の配線は、第 2 のコンテキストデータ信号を前記第 4 のトランジスタのゲート  
に供給する機能を有し、

前記第 1 の回路は、前記第 1 のコンフィギュレーションデータを保持する機能を有し、

前記第 2 の回路は、前記第 2 のコンフィギュレーションデータを保持する機能を有する  
半導体装置。

**【請求項 3】**

請求項 1 または 2 において、

前記第 1 のトランジスタおよび前記第 3 のトランジスタは、酸化物半導体を有する半  
導体装置。

**【請求項 4】**

請求項 1 乃至 3 のいずれか一項において、

前記第 1 の回路は、第 5 のトランジスタと、第 1 の容量素子と、を有し、

前記第 2 の回路は、第 6 のトランジスタと、第 2 の容量素子と、を有し、

前記第 5 のトランジスタおよび前記第 6 のトランジスタは、酸化物半導体を有し、

前記第 5 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 1 の配線と電氣的に  
接続され、

前記第 5 のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第 1 のトランジスタの  
ゲートと電氣的に接続され、

前記第 1 のトランジスタのゲートは、前記第 1 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続  
され、

前記第 6 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 1 の配線と電氣的に  
接続され、

前記第 6 のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第 3 のトランジスタの  
ゲートと電氣的に接続され、

前記第 3 のトランジスタのゲートは、前記第 2 の容量素子の一方の端子と電氣的に接続  
されている半導体装置。

**【請求項 5】**

請求項 1 乃至 4 のいずれか一項において、

第 7 および第 8 のトランジスタを有し、

前記第 7 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 2 のトランジスタの  
ゲートと電氣的に接続され、

前記第 8 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 4 のトランジスタの  
ゲートと電氣的に接続されている半導体装置。

**【請求項 6】**

請求項 5 において、

前記第 7 のトランジスタおよび前記第 8 のトランジスタは、酸化物半導体を有する半  
導体装置。

**【請求項 7】**

請求項 3、4 及び 6 のいずれか一項において、

前記酸化物半導体は、In と、Zn と、M (M は Al、Ti、Ga、Sn、Y、Zr、  
La、Ce、Nd または Hf) と、を有する半導体装置。

**【請求項 8】**

請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載の半導体装置と、

当該半導体装置と電氣的に接続されたリードと、を有する電子部品。

**【請求項 9】**

請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載の半導体装置または請求項 8 に記載の電子部品と、  
表示装置、タッチパネル、マイクロホン、スピーカ、操作キー、および筐体の少なくとも一つと、を有する電子機器。